	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS018C(单胞)	文件编号	XS-R-044
	肖特基二极管	版本号	18-A5-05
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W1XS018C 与 MOS 管组合封装的成品管主要用于 Li 电池充电、DC/DC 转换。

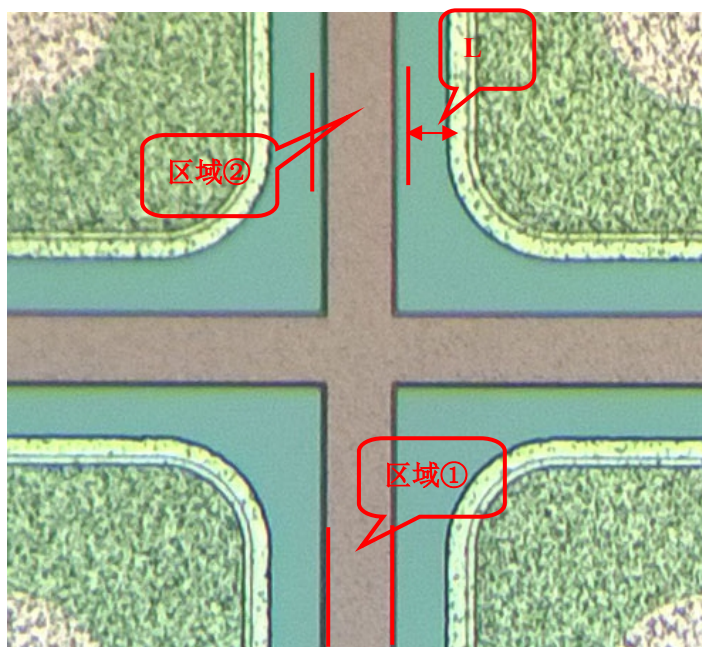
1.2 主要特点

- 低正向压降
- 高电导性
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸	0.70 mm×0.70 mm	
		27.56 mil×27.56	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	220±20	
	划片道*尺寸 (μm)	50	
	键合区面积 (μm ²)	正面	400×400
	正面电极 (阳极)	金属	铝
		厚度	5.0±1.0
	背面电极 (阴极) (推	表层金属	金
	硅片直径 (mm)		φ125
	装片要求 (推荐)		共晶
	键合要求 (推荐)		2 根 φ32μm 铜线

* 划片道位置示意图:



备注: 区域①为划片刀走刀区域, 划片时应在两条参考线中间; 区域②为划片道区域, 宽度为 50 μm; 划片时划片道边缘到铝的距离 L 不小于 31 μm 即判定为合格。


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS018C(单胞)	文件编号	XS-R-044
	肖特基二极管	版本号	18-A5-05
		页码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

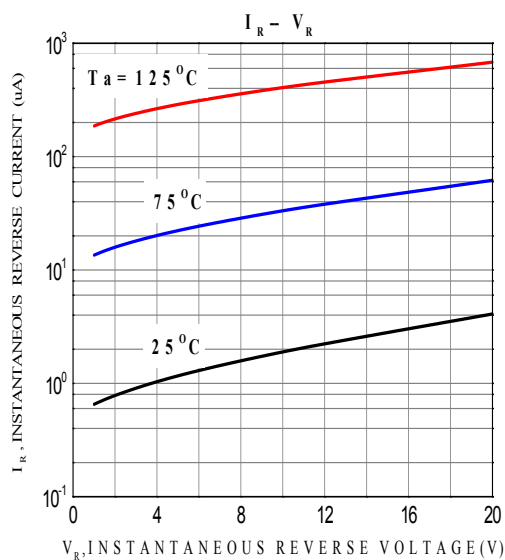
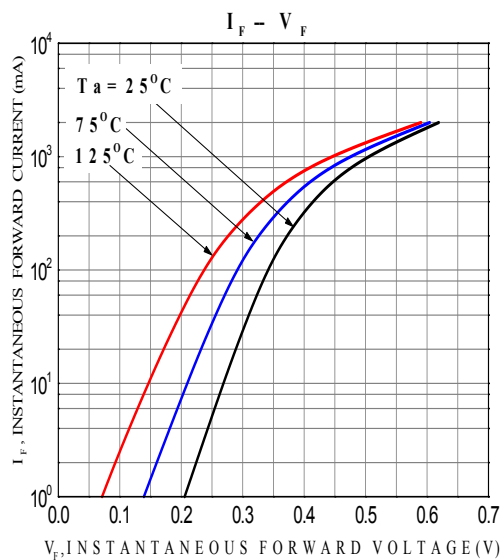
参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	20	V	推荐封装形式: DFNWB2*2-6L 推荐成品型号: 与 MOS 管配套封装的成品 CJMP06
正向电流	I_D	1	A	
结温	T_j	110	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=100\ \mu\text{A}$	20	—	—	V
反向电流	I_{R1}	$V_{R1}=10\text{V}$	—	—	5	μA
反向电流	I_{R2}	$V_{R2}=20\text{V}$	—	—	15	μA
正向电压	V_{F1}	$I_{F1}=0.1\text{A}$	—	—	0.4	V
正向电压	V_{F2}	$I_{F2}=0.5\text{A}$	—	—	0.5	V
正向电压	V_{F3}	$I_{F3}=1\text{A}$	—	—	0.575	V

3.3 典型特性曲线




江阴新顺微电子有限公司

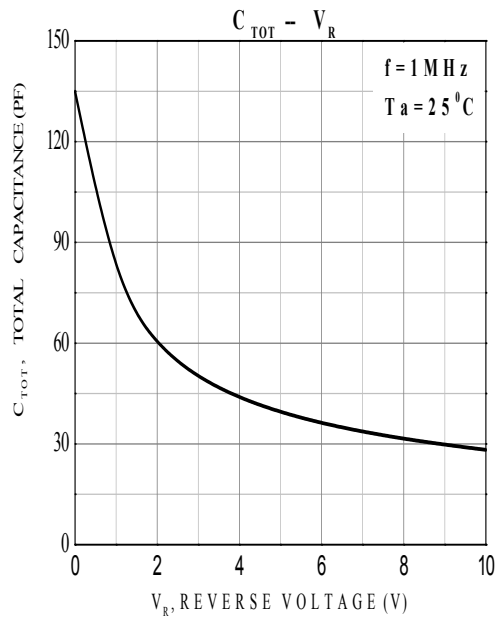
地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS018C(单胞)	文件编号	XS-R-044
	肖特基二极管	版本号	18-A5-05
		页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电 话：(0510) 86851182

网 址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传 真：(0510) 86851532